

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-243627

⑤Int Cl.⁴ C 08 J

識別記号

庁内整理番号

昭和62年(1987)10月24日 43公開

7/00 H 01 L 21/90 H 05 K 3/18

306 7206-4F S-6708-5F A-6736-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全9頁)

図発明の名称

有機表面の粗面化方法

創特 昭62-43260

22日 願 昭62(1987)2月27日

優先権主張

砂1986年4月14日砂米国(US)砂851856

@発 明者 キヤロル・ルース・ジ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ビンガムトン、ウェスト・

ヨーンズ

ハムトン・ロード 2129番地

@発 明者

ロビン・アン・サスコ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州オエゴ、ボツクス401、ア

ール・ディ1番地

の出 願 人

インターナショナル ビジネス マシーンズ アメリカ合衆国10504、ニユーヨーク州 アーモンク (番

地なし)

コーポレーション

⑪代 理 人 弁理士 岡田 次生

外1名

明 細

1. 発明の名称 有機表面の粗面化方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 基板の有機表面を酸素を含むプラズマで処理 することを含む、有機表面の粗面化方法。
- (2) 前記基板の有機表面を予めシリコンを含む物 質で処理するととを含む、特許請求の範囲第(1)項 記載の方法。
- (3) 前記プラズマが、CF₄、C₂F₆、CF₃C₆、 SF₆、CC_{ℓ2}F₂及びNF₃の中から選択さ れたフツ素化合物を約2乃至70モル8の量含む、 特許請求の範囲第(1)項又は第(2)項記載の方法。
- (4) 前記シリコンを含む物質で処理することによ り、前記基板の有機表面が少なくとも約0.5原子 量系のシリコンを含む、特許請求の範囲第(2)項記 載の方法。

3.発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

本発明は、表面を粗面化して他の有機表面およ びその上に被覆された金属に対する接着力を改善 するために、酸素を含むブラズマで、シリコンに よつて改変された有機表面を処理することに関す るものである。

B. 従来技術

工業の応用分野では、有機表面を顕微鏡レベル で均一に粗面化することが望ましい場合がしばし ぱある。

とくに、コンピューター工業で、チップと呼ば れる情報処理デバイスを実装するための第 1 レベ ルおよび第2レベルのパッケージを製造する際に、 かかる粗面化が窒ましい。

かかる製造の際には、銅を有機表面に容易には ずれないように貼りつけることが望ましい場合が しばしばある。有機表面を粗面化すると、金属の

接着力が増すことが知られている。銅の付着力を 改善するため、有機表面の均一な粗面化を伴なり 様々な工業的方法が開発されている。大部分のか かる方法はりまく働らくが、何らかの問題や欠点 を伴なつており、その克服が求められている。

C. 発明が解決しようとする問題点

先行技術の一方法では、有機表面に銅の犠性層を貼りつけ、次にそれを剝がして、有機表面の幾何形状を、平滑度が減つてめつき浴から銅の無電解めつきを受け入れやすくなるように改善させている。 この方法はうまく働き、広く使用されている。 しかし、この方法は、高価な銅を大量に消費するという欠点がある。

やはり広く使われている別の先行技術の方法では、銅を付着する前に、有機表面に薄いクロム層を付着させる。との方法がどのようにして有機表面に対する銅の接着力を高める働きをするのかは完全にはわかつていないが、クロムが有機表面と化学的に反応し、または静電的に有機表面に付着

コンピューター工業では、第1レベルおよび第 2 レベルのパッケージを製造する際に、ブリント 回路板などの有機構造体中に穴あけまたはエッチ された、普通"スルー・ホール"や"ヴァイア" と呼ばれる穴や内部結線の壁面をめつきする必要 のある場合がしばしばある。穴あけすると、回路 板の有機材料が汚れ、またそれが信号平面、電力 平面、接地平面など、後でスルー・ホールの壁面 に金属層をめつきして接続を設けるために露出し たままにしておくことが望ましい電気的相互接続 面即 ちインタープレーン (interplane)がそ れて覆われてしまい、ヴアイアやスルー・ホール の汚染除去が必要になる。従来、汚染除去は、サ ンドプラスト処理、化学的処理、プラズマ処理な よびそれらの組合せによつて行なわれてきた。し かし、サンドプラスト処理で効果的に汚染除去を 行なうのは難かしく、アスペクト比の大きなスル ー・ホールではとくに効果がない。塩酸やメチル カルピトールなどの物質、あるいはクロム酸、硫 酸およびn-メチルピロリジノンを使つた穿孔壁

するものと考えられている。クロムは高価な金属であり、また有機材料に対する銅の接着力を高めるためにクロムを使うと、パッケージ工程が1ステップ増える。クロムの電気抵抗率がかなり大きいため、多くの用途ではその使用が望ましくないと思われる。クロムは、通常スパッタ法または蒸着法で付着されるが、それが好都合なのは通常、ブリント回路板よりもサイズが小さな構造の場合だけである。

サンドプラスト処理は、後で金属を付着するために、または第2の有機材料に貼りつけるために、有機表面を粗面化するのに先行技術で使われているもり1つの方法である。有機積層構造中の少なくとも1層の表面を粗面化すると、粗面化された表面とそれに隣接する層との間の接着力が向上するととが知られている。サンドプラスト処理は、有機表面を均一に粗面化するには効果があり得るが、ときには処理すべき表面の微細形状を破壊する恐れがあり、また割れ目や穴の深くまでは浸透しない。

面の液体による汚染除去は効果がある。かかる薬品を使うと、壁面が汚染除去され、後で金属を無 電解めつきするのに充分な程度に粗面化される。 しかし、これらの液体は、ときに有機材料をエッチしすぎてインターブレーンをアンダーカットしたり、またときに作業員の安全と環境保護の点から望ましくないことがあり、付着された金属の腐食や移動に関して潜在的に信頼性の点で問題があるという欠点がある。

ブラズマ処理による穿孔スルー・ホールの汚染除去が試みられ、効果のあることが判明している。しかし、ブラズマによる汚染除去は、穴の壁面の有機材料の表面が非常に平滑になるので、後の金属の無電解めつきが非常に難かしくなり、かかる付着の前に表面を粗面化する必要がある。

1983年10月に米国電気化学会のブラズマ・シンポジウムの議事録の一部として、エポキシ樹脂の表面を粗面化する方法を記載した、R.H.ウイーター(Wheater)等の論文が発表された。 この方法では、エポキシ樹脂を二酸化シリコン粒 子で充填し、O2/CF4プラズマにさらした。 樹脂袋面の二酸化シリコン粒子は、酸素を含むブラズマの影響を受けなかつたが、その間にあつたエポキシ樹脂は除去され、表面が粗面化された。 未処理のエポキシと銅に対する接着力の増大が認められた。しかし、エポキシ中の二酸化シリコン粒子が、強度、加工性、レオロジーといつたその諸特性を変化させた。このことは、とくに基板や半導体など、第1レベルの電子パッケージを製造する際には望ましくない。

D. 問題点を解決するための手段

本発明の目的は、先行技術の欠点を克取するとと、即ち、実質上有機性の表面を均一に粗面化することである。

本発明により、実質上有機性表面とその表面に 被覆される金属層の間の接着力を高めることがで きる。

また、本発明により、基本的に有機物である積 屠表面間の接着力を高めることができる。

び(b)処理した表面を酸素を含むブラズマにさらす ことの連続する各ステップを含んでいる。

本発明の第3の態様は、有機表面にシリコンで 改変した表面を貼りつける方法の改良に関するも ので、この方法は表面を加圧接触にかけることを 含んでおり、その改良はシリコンで改変した表面 を加圧接触にかける前に酸素を含むブラズマにさ らし、それによつてシリコンで改変した表面と有 機表面の間の接着力を高めることを含んでいる。

本発明の第4の態様は、第1の有機表面を第2 の有機表面に貼りつける方法の改良に関するもの で、この方法は前記第1の表面と第2の表面を加 圧接触させることを含んでおり、その改良は(a)前 記第1の有機表面と第2の有機表面の少なくとも 一方をシリコンを含む物質で処理すること、およ び(b)処理した表面を酸素を含むブラズマにさらし、 それによつて前記第1の表面と第2の表面の間の 接着力を高めることの連続する各ステップを含ん でいる。

本発明の第5の態様は、有機表面を金属で被覆

さらに、本発明により、 層間の接着力が大きな 成層構造を提供することができる。

本発明では、シリコンで改変した表面を、酸素を含むブラズマで処理して粗面化する。必要な場合、ブラズマ処理の前にシリコンを含む物質で処理して、有機表面をシリコンで改変する。粗面化された表面は、他の有機表面かび行着された金属を付着させる方法が設度が提供される。また有機層間または金属と有機表面の間の接着力が向上した、積層有機層または有機表面に付着された金属を含む構造も提供される。

本発明の1つの憩様は、シリコンで改変した有機表面を租面化する方法に関するもので、この方法は表面を酸素を含むブラズマにさらすことを含んでいる。

本発明の第2の態様は、実質上有機性の表面を 改変する方法に関するもので、この方法は(a)有機 表面をシリコンを含む物質で処理すること、およ

する方法の改良に関するもので、この方法は有機 表面上に金属を付着させることを含んでおり、そ の改良は、付着を行なり前に(a)有機表面をシリコンを含む物質で処理すること、および(b)処理した 表面を酸素を含むブラズマにさらし、それによつ て有機表面と付着された金属の間の接着力を高め ることの連続する各ステップを含んでいる。

本発明の第6の態様は、シリコンで改変した有機表面を金属で被覆する方法の改良に関するもので、この方法は金属を含む浴から前記の有機表面上に金属層を無電解めつきすることを含んでおり、その改良は、金属の無電解めつきを行なら前に、シリコンで改変された表面を酸素を含むブラズマにさらし、それによつてシリコンで改変された表面と無電解めつきされた金属の間の接着力を高めることを含んでいる。

本発明はまた、有機層が本明細書に記載する本 発明の方法で処理された、または有機層がシリコ ンで改変された有機材料を含み、かつ本発明の方 法で処理された、有機層上に有機材料または金属 が被覆されている成層構造をも対象とする。

E. 実施例

本発明は、シリコンで改変された表面を酸素を含むプラズマにさらすと、その表面が均一に相面化されて、有機表面および被覆された金属に対する接着力が向上することの発見にもとづくものである。

本発明では、有用な有機表面とは、酸素を含む ブラズマの作用によつて影響を受けるのに充分な 量の有機物質を含む表面をいう。コンピューター 工業ので第1レベルを第2レベルのパッケージ を製造する際に通常使用される樹脂が、かかる樹脂の例である。もちろん、樹脂技術の当業者にと なびずである。かかる有用な樹脂の例は、ビスフ エノールA/エピクロロヒドリン樹脂、エポキシ 樹脂、ノボラック樹脂をひボリイミドである。 ことができる。たとえば、シリル化(silylate)

と、粗面化の均一さや深さはそれ以上改善されない。したがつて、有機表面をシリコンを含む物質で、表面のシリコン含有量が約5~25原子量がになるように処理することが好ましい。

本発明の方法によつて粗面化できる有機樹脂には、シリコンを含む部分を有するポリマーからできているものがある。表面処理した樹脂の場合と同じく、シリコンを含むポリマーからできている樹脂も、酸素を含む励起ガスに対して約5~25原子量のシリコンを呈示する場合に最もよく粗面化される。

シリコンで改変した表面を、励起状態の、すなわちブラズマ状態または反応性イオン・エッチ(RIE)状態の酸素を含むガスにさらす。かかる励起されたガスは、ブラズマ状態のものでもRIE状態のものでも、"ブラズマ"と呼ばれることが多く、本明細掛の他の個所で"ブラズマ"の語を使う場合は、その意味を含むものとする。表面

したり、光開始剤(photoinitiator)を加 えたりすることができる。

シリン化ポリマーを含まない樹脂は、本発明の 方法の第1ステップとして、シリコンで表面を改 変しなければならない。かかる改変は、シリコン を含む液体の蒸気に表面をさらして、少なくとも 若干のシリコンを表面に付着または吸収させるこ とにより、実施できる。シリコンを含む物質を表 面に付着させるための有用な方法は、スピン・コ ーティング、ディップ・コーティング、および蒸 気接触によるものであるが、それらは周知の手法 である。

シリコンで改変した有機表面は、酸素を含む励 起ガスに実質上どれだけのシリコンを呈示するも のでも、粗面化されることが判明している。しか し、表面のシリコン含有量が約5原子量多を下回 ると、粗面化が弱くなつたり不規則になつたりす ることがある。有機表面のシリコン含有量が約5 原子量多を越えると、かなりよい結果が得られる。 表面のシリコン含有量が約25原子量多を越える

処理に使用する圧力、ガス流量および電力は、本方法の実施にとつて重要ではない。ただし、ガスの酸素含有量は重要である。すべて酸素だけのプラズマは、粗面化の進行が遅いものの、本発明で効果を示すことが判明している。また、酸素含有量が約30モル%を下回つた場合、粗面化は起こらないことも判明している。(通常のブラズマ発生装置のガス圧では、モル%と体積%はほぼ同じ値になる)。

ブラズマは、酸素以外のガスを含んでいてもよい。通常、他のガスは、フツ素化合物、たとえば CF4、C2F6、CF3Cl、SF6、CCl2F2、NF3 などである。これらのフツ素化合物は、本発明のブラズマ中に約2~70モル%の量だけ存在するのが普通である。ブラズマ中にCF4がわずか2 モル%存在するだけで、表面の粗面化の速度が増し、またCF4 歳度が約70モル%をかなり越えると、ブラズマが表面からシリコン体をエッチし始めることが判明している。ブラズマ中のフッ素化合物ガスの歳度が好ましい約30モル%のとき、



動作速度が最適になる。

CF4は、入手しやすく、扱いやすく、大部分の有機基板および後で基板上に付着する金属との化学的融和性があるため、好ましいフッ素化合物ガスである。

本発明の機構は、完全にはわかつていない。酸素を含むプラズマが樹脂表面のシリコン体(sillcon entity)を二酸化シリコンに変換し、同時にシリコン体の間にある有機物質をエッチするものと考えられている。

後のステップで、プラズマ処理した表面を、 CF4などのフッ素化合物を70%モル以上含む 励起ガスにさらして、表面上の二酸化シリコン材料を除去し、シリコン材料を含む粗面化された有 機表面を得ることもできる。

無電解めつき(続いて電解めつきを行なうものでも行なわないものでもよい)、スパッタリング、蒸着など既知のいずれかの方法を用いて有機表面を積層する際、本発明は、積層表面間の接着力を高めるのに役立つ。積層有機表面間の接着力は、

らす。

かかる処理の後、部材1と2を加圧下で貼り合わせて、第1図に示す構造を形成する。この構造は、界面3での前記部材1と2の間の接着力が高まつている。

有機部材 1 が既にシリコンで改善された物質ではない場合、前述のようにその表面が粗面化の間酸素を含むプラズマにシリコン体を呈示するように、その部材をシリコン材料で表面処理する。シリコン処理なよび酸素を含むプラズマによる処理の後、部材 1 と 2 を加圧下で貼り合わせて、第 1 図に示す構造を形成する。 この構造は、界面 3 での前記部材間の接着力が高まつている。

第1図の構造は、工業の応用分野で多数の用途がある。これは、有機表面の積層体を使用し、かつかかる積層体の層間の接着力が重要である、情報処理装置用パッケージの製造にとくに有用なことが判明している。

具体的に第2図を参照すると、めつきしたスルー・ホール6とプリント回路線 7を含むプリント

一方の有機表面に本発明の方法を施した後、約5倍に高まることが判明している。

無電解めつき(続いて電解めつきを行なりものでも行なわないものでもよい)、スパッタリング、蒸着など既知のいずれかの方法によつて有機表面上に金属を被覆する際、本発明は、被覆される金属と有機基板の間の接着力を高めるのに役立つ。金属を被覆する前に有機基板を本発明の方法で処理すると、接着力が3倍以上に高まることが観察されている。

具体的に第1図を参照すると、界面3で層状に接触する有機部材1と2を含む構造が、断面透視図として示してある。有機部材1と2は、上述のような有用な有機材料でできている。部材1と2の少なくとも一方の界面が、本発明の方法に従って処理される。

有機部材 1 がシリコンで改変された物質、たと えばシリル化ビスフェノール A /クロロヒドリン 樹脂の場合、部材 1 の部材 2 と層状に接触する側 の表面を、上述のように酸素を含むブラズマにさ

回路板5の一部分が断面透視図として示してある。 ブリント回路線7とめつきされたスルー・ホール 6を支持する有機基板8は、金属のブリント回路 線7かよび金属めつき11と有機基板8との間の 接着力を高めるため、上記のような本発明の方法 によつて、ブリント回路線7を支持する表面9と めつきされたスルー・ホール6内のめつき11を 支持する表面10が処理される。

第1図の部材1の場合と同様に、有機基板8がシリル化された有機物質でできている場合、めつき11とブリント回路線7を付着する前に、基板表面を酸素を含むプラズマにさらす。ただし、有機基板が既にシリル化されているのでない場合は、プラズマ処理の前に、シリコンを含む物質で基板を表面処理する。

F. 発明の効果

下記の例によつて、本発明の様々な態様を明らかにし例示する。ただし、それらの例は本発明の 範囲を限定するものではない。 例 1

ユニオン・カーバイド社からPKHHの商品名で市販されている、1反復単位当り平均1個の水酸基を有する、高分子のピスフエノールA/エピクロロヒドリン(n=100)樹脂の15重量系溶液を、シオキサン溶媒と混ぜ、2枚のガラス製スライドにスピン・コートした。コートしたスライドを100℃で5分間加熱して、溶媒を除去した。

樹脂で被覆したスライドのらち1枚を、次にヘキサメチルジシラン(HMDS)に浸漉して、デイップ・コートした。過剰のHMDSをスピン・オフし、その後、樹脂で被覆されシランで処理されたスライドを100℃で10分間加熱して、痕跡量の溶媒を飛ばした。

シランで処理したスライドとシラン未処理のスライドを、各スライドの半分がプラズマにさらされ、半分がさらされないように、改良型テガル(Tegal)プラズマ・エッチャに入れた。 20標準cml/分(sccm)の酸素を使つて、電力密度0.

ジグライム(diglyme)溶媒とテトラヒドロフラン溶媒を使つて、例1の手順を繰り返したが、 結果にはつきりした変化はなかつた。

例 3

水酸基をシランで置換してシリル化した、高分子のシリル化ビスフェノールA/エピクロロヒドリン(n=100)樹脂の4.5 メジオキサン溶液を調製し、ガラス製スライドにスピン・コートした。スライドを短時間加熱して、痕跡量の溶媒を除去した。

例1の手順に従つて、スライドをブラズマ処理 にかけ、続いて検査した。スライドのプラズマ処 理区域に、均一な表面の粗面化が観察された。

例 4

ダウ・ケミカル社から市販されているビスフェ ノールAエポキシ樹脂(n=10~13)のジグ リンジルエーテルであるDER667を8部と、 ダウ・ケミカル社から市販されているビスフェノ ールAエポキシ樹脂(n=0)であるDER33 2を2部と、4ーアミノフエニルスルホン1部を、 4 3 ワット/cmlで、サンブルをそれぞれ反応イオン・エッチ(RIE)方式で 2 0 分間プラズマ・エッチした。

エッチングの後、プロフィロメータ

(profilometry)と走査型電子顕微鏡を使って、各スライドのプラズマで処理した部分とプラズマ未処理の部分を検査した。シランで処理したスライドのプラズマ処理部分よりも粗面度が高かった。プロフィロメータ調定では、プラズマ処理後に、シラン未処理の表面でRaが1.0μm(40マイクロインチ)、シラン処理表面でRaが2.9μm(114マイクロインチ)であるとが示された。

粗面化は、ほぼ均一であるように見えた。 15°の観測角度でも粗面化が観測できたものの、走査型電子顕微鏡で角度が 60°のとき、粗面化が最もよく観察された。

例 2

ジオキサン溶媒35部とジグライム溶媒22部中で混ぜて、樹脂処方を調製した。

この樹脂処方を2板のガラス製スライドにスピン・コートし、200℃で3時間硬化させて、T_g120℃および有機溶媒を通さない状態にした。

2板のスライドのうち1枚を、例2の手順に従 つてHDMS中でデイップ・コートし、乾燥した。 両方のスライバトを酸素プラズマにさらし、続い て例1の手順に従つて検査した。

ブラズマ処理したシラン処理表面では、他の表面に比べて著しい均一な粗面化が観察された。

例 5

官能性水酸基を有するポリイミドをジグライム で4倍に希釈し、2枚のガラス製スライドにスピン・コートしてから、130℃で30分間、続いて275℃で30分間の2段階硬化を行なつた。

スライドのうち1枚を、例1の手順に従つて、 HMDSでデイップ・コートし乾燥した。両方の スライドを酸素プラズマにさらし、続いて例1の 手順に従つて検査した。



プラズマ処理したシラン処理表面では、他の表面に比べて著しい均一な粗面化が観察された。

例る

Kを乾燥させた。

シップレイ社から商品名A21350Jで市販されている、ノボラック樹脂を主成分とする標準のポジテイプ・フォトレジストを3枚のガラス板にスピン・コートし、80℃で30分間硬化させた。

スライドのうち 1 枚を、温度 2 5 ℃で一般式 C 6 H 5 (CO)S_i (CH₃)₃ で表わされる 感光性有機シリコン錯体の蒸気雰囲気にさらした。 2 枚目のスライドを、P S K 中で 1 分間ディップ・コートし、100℃で10分間加熱してP S

3枚のスライドすべてを、化学線のフラッド露出にかけ、続いて酸素ブラズマで処理し、次に例1の手順に従つて租面度を検査した。

蒸気処理したスライドとディップ・コートした スライドのプラズマ処理部分では、著しい粗面化 が観察された。

配置された 2 個のホイールの 1 つずつに、 積層体の各層を取りつけた。 積層体を引つ張つてホイール間のニップ中を通し、ニップを出たとき引き離した。 Instronゲージなどホイールに接続された張力測定装置で、 積層体がニップの所で分離するときの力を測定した。 積層体を分離させるのに必要な力は、 0.74 kg/cd (10.5 ポンド/インチ)より大きかつた。

例 8

例1のようにして、ビスフェノールA/エピクロロヒドリン樹脂を調製し、デイップ・コーティングでHDMSで処理し、例7の手順に従つて試験し、ほぼ同様の結果を得た。

例 9

ノボラック樹脂を調製し、例6と同様にシラン 蒸気で処理してから、例7の手順に従つて試験し、 ほぼ同様の結果を得た。

例 1 0

積層体を調製し、樹脂層を積層する前にプラズ マ処理にかけなかつたこと以外は例 7 と同様にし 例 7

樹脂混合物を銅(1.7ミル即ち0.043 mm)シ ートの 5.0 8 cm×3 0.4 8 cm (2 インチ× 1 2 イ ンチ)のストリップ上に硬化させた以外は例ると 同様にして、シリル化ピスフェノールA/エピク ロロヒドリン樹脂のサンプルを調製した。硬化し た樹脂のストリップ全体をガス組成が0, 62% とCFA 38%、電力密度約0.05ワット/all、 圧力250ミリトールのプラズマに5.3分間さら した。その後、ほぼ均一な粗面化が観察された。 ・次に後のテストの際に分離しやすくするため、 一端でストリップの間にマイラー・スリップ・シ ートを入れて、ストリップを加圧下で同じ寸法の 硬化エポキシ樹脂ストリップに貼り合わせた。温 度175℃で35.2 Kg/cd(500ポンド/平方イ ンチ)の圧力を80分間かけ、続いて35分間冷 却した。積層中、構造に対して 2.1 1 kp/cml(3

積層体を"ワゴン・ホイール"引離し試験にかけ、ほぼ接触しながら反射方向に回転するように

0ポンド/平方インチ)の真空をかけた。

て試験した。積層体を分離するのに必要な力は、 約0.088 kg/cd(約1.25 ポンド/インチ)で あつた。

例 1 1

積層体を調製し、積層する前に樹脂をから焼きして揮発性物質を除去したこと以外は例10と同様にして試験した。積層体を分離するのに必要な力は、約0.14 Kg/cd(約2ポンド/インチ)だつた。

例 1 2

シリコン濃度が約0.5、1、5、10、15、20、25 および40原子最多の一連の樹脂を作るため、官能性水酸基をもつエポキシおよび官能性水酸基をもつノポラックを様々な量のシリル化剤と反応させて、シリコンを含む有機樹脂を調製した。計算した原子量多を赤外分光法で確認した。スピン・コーティングによつて樹脂をガラス製スライドに被覆し、充分に乾燥させて痕跡量の溶媒を飛ばした。

コートしたスライドは、平面の平滑度を検査し、

次に圧力約160ミリトール、平均電力約0.86 ワット/cd、ガス流量約20sccmで酸素プラメマに約5分間さらした。スライド表面で2回目の検査を行ない、粗面度が上昇しているかどうか調べた。

プラズマ処理の前後の表面の走査型電子顕微鏡 検査から、あらゆるシリコン濃度で、サンプル表 面の機械的粗面化が行なわれたことがわかつた。 シリコンを 5 原子量 5 未満しか含まないサンプル の粗面化は弱いことがあり、シリコンを 2 5 原子 量 5 以上含むサンプルの粗面化は、程度の増加を みなかつた。

例 1 3

ガラス布を含む第1の基板に、直径0.46 mm (18ミル)の穴のバターンをあけた。続いてP_d/S_n シードで穴をシードし、鋼を厚さ約0.025 mm (約1ミル)まで無電解めつきした。

同様の第2の基板に、同様の穴のパターンをあけた。ただし、穴を清浄化した後シーディングの前に、HMDS中でディップ・コートし、乾燥し、

で分析して、シリコン化合物の存在を確認した。

次に粗面化した表面を、電力約0.05ワット/ dd、CF485%/0215%でプラズマに約30分間さらし、粗面度とシリコン含有量を再度検査した。平均粗面度はほぼ同じままであることが判明したが、痕跡量のシリコンのほぼすべてが表面から除去されていた。

C F 4 含有量が約 2 原子県 8、平均電力約 0.0 7 <u>分</u> ワット / cd で 0 2 / C F 2 プラズマで約 3 0 分間 処理した。プラズマ処理の後、第 2 の基板を第 1 の基板と同様にシードし、無電解めつきした。

両方の基板をめつきスルー・ホール(PTH)接着力試験にかけ、めつきしたスルー・ホールを 長手方向に切断し金属が分離点で樹脂に対して垂 直になるようにして金属の内部被覆を遅打ちの樹 脂から引き剝がし、引き剝がしに要する力を金属 に取りつけたInstronゲージで測定した。

第1の基板では、めつきしたスルー・ホール内の金属被覆を周囲の樹脂から分離するのに必要な平均の力は769/mmであつた。第2の基板では、必要な平均の力が2439/mmであつた。

例 1 4

表面のシリコン含有量が約10原子量まである、 例12と同様にして調製した樹脂で被覆したスライドを、酸素を含むプラズマにさらし、プロフイロメータと走査型電子顕微鏡で検査して、表面の 粗面化を確認した。粗面化した表面を赤外分析法

表面をブラズマ処理に備えて調製できることも自明のはずである。さらに、かかる当業者には、本発明を実際する際に酸素を含む他のブラズマが役立つこと、および例に示したもの以外の様々な構造が本発明の範囲内に含まれることも自明のはずである。

以上、当業者が本発明を行ない、使用し、本発明を実施する最良の方式を知り、また本発明を他の発明および従来技術から区別することができるだけの充分な明瞭さと簡潔さで上記の教示および添付の図面において、本発明を開示した。本発明の様々な変化形と明白な改造が容易に思い浮かぶはずであるが、それらは特許請求の範囲に記載したごとき本発明の範囲に含まれるものとする。

4.図面の簡単な説明

第1図は、層間の接着力が改善された有機材料 の積層体を示す図、第2図は、有機基板に被覆さ れ、基板に対する接着力が改善された金属を示す 図である。



